

## GaN 中子探测器的制备

*Tuesday, 16 October 2018 08:30 (15 minutes)*

采用  ${}^6\text{LiF}$  转换层和高密度聚乙烯慢化剂成功制备了 GaN 基 pin 中子探测器。估算了  ${}^6\text{LiF}$  厚度为  $16.9\ \mu\text{m}$  的中子探测器的中子探测效率在  $-10\text{V}$  的反向偏压下约为 1.7%。

**Primary author:** Dr 朱, 志甫 (东华理工大学)

**Presenter:** Dr 朱, 志甫 (东华理工大学)

**Session Classification:** 第一分会场 (1)

**Track Classification:** 核探测器及其应用的研究成果